PRESS RELEASE

# CGD 將首次參與中國 PCIM Asia 展覽，發表易用可靠的 ICeGaN GaN HEMT 系列

**歡迎於 8 月 29 至 31 日蒞臨上海新國際展覽中心 2G18 展位**

2023 年 8 月 04 日

**【英國劍橋訊】**[Cambridge GaN Devices (CGD)](https://camgandevices.com/) 是一家無晶圓廠潔淨技術半導體公司，專門開發**和量產**一系列節能 GaN 型功率裝置，旨在實現更環保的電子元件，該公司將首次在中國唯一專門展示功率電子元件的 PCIM Asia 展覽會展出智慧運動、再生能源和能源管理領域的應用產品。CGD 同時將在中國首次發表易於使用、穩定可靠的 ICeGaN™ GaN HEMT **第 2 波系列產品**，將在整個展位進行示範，並於活動期間發表主題演講，以及兩場技術應用簡報。

Cambridge GaN Devices 技術長 Florin Udrea 教授將於 8 月 29 日星期二上午 10:00 發表開幕主題簡報，主題為：「新一代氮化鎵功率裝置；突破易用性和可靠性的限制」。

CGD 資深首席應用工程師 Martin Cheung 將於 8 月 29 日星期二上午 11:25 發表題為「減少高效能充電器拓撲中的穩態損耗」的講座，並於隔天 8 月 30 日星期三上午 10:55 發表「調校 GaN 切換效能及並行運作」的演說。

|  |
| --- |
| Andrea Bricconi | CGD 商務長 「中國和亞洲市場對 CGD 至關重要，**我們將持續擴大產品組合**，努力為全球市場提供創新、易用、堅固且可靠的 GaN 解決方案。CGD 將在中國的 PCIM Asia 展覽會首次展示我們的 H2 系列 ICeGaN™ HEMT 解決方案。我們榮幸首次參加亞洲最頂尖的功率應用展覽會，在現場與現有和潛在的新客戶會面，傾聽他們的應用現況，以利我們推出最合乎需求的解決方案。」 |

**關於Cambridge GaN Devices**

Cambridge GaN Devices (CGD)專注於GaN晶體管和IC的設計、開發和商業化運作，能夠激發能源效率和高密度層面的根本性變革，確保產品適合投入大量生產。我們的使命是透過提供節能易於使用的 GaN 解決方案，將創新帶入日常生活。 CGD 的 ICeGaN™ 技術已被證明適用於大批量生產，並且透過製造和客戶合作夥伴關係迅速擴大規模。CGD是一家由英國劍橋大學衍生而立的無晶圓廠半導體公司，其創始人 CEO Giorgia Longobardi 博士和 CTO Florin Udrea 教授仍然與劍橋大學世界知名的高壓微電子和傳感器集團 (HVMS) 保持著密切聯繫。CGD致力於創新科技的發展，使得其 ICeGaN HEMT 技術受到強大且不斷增長的知識產權組合的保護。 CGD 團隊的技術和商業專長，加上在電力電子市場的廣泛業績，是市場接受其專有技術的基礎。

### 新聞稿連絡人：

Amanda Lin, Marketing Communication Manager, CGD / 0953459875

[Amanda.lin@camgandevices.com](mailto:Amanda.lin@camgandevices.com)

1106, 11F, N.502, Sec 2, RenAi Rd, Linkou Dist, New Taipei City, Taiwan

Andrea Bricconi, Chief Commercial Officer, CGD | +49 1732410796

[andrea.bricconi@camgandevices.com](mailto:andrea.bricconi@camgandevices.com)

Jeffreys Building, Suite 8, Cowley Road, Cambridge CB4 0DS